

RFMD 新闻发布



联络方式:

RF Micro Devices Inc.
Irma Swain, 企业公关经理
7628 Thorndike Road
Greensboro, NC 27409-9421, USA
电话: +1 (336) 931-6653
iswain@rfmd.com

RFMD® 通过了第一代氮化镓 (GaN) 工艺技术认证

GaN 技术支持 RFMD 多市场产品组的众多产品

纽约 - 2007 年 11 月 21 日 - 日前, 设计与制造高性能射频系统与解决方案的全球领先者 RF Micro Devices (Nasdaq GS 股市代号: RFMD) 在其分析日宣布, 公司已通过了第一代 48V 氮化镓 (GaN) 工艺技术的技术认证。

RFMD 堪称全球领先的复合半导体制造商, 公司充分利用了现有制造资产以及在高量产复合半导体设计与制造方面业经验证的专业技能, 以提供其最新 GaN 工艺技术所具有的出色热性能及 RF 性能。RFMD 已开始向多个终端市场中的客户预批量发运其 48V GaN 技术。

RFMD 的 48V GaN 工艺技术非常适于满足客户日益增长的对更高功率、更高效率及更大带宽的需求。公司正在瞄准多个高增长应用, 包括高线性有线电视线路放大器、军用雷达应用、高带宽无线基础设施功率放大器, 以及面向创新高亮度光发生应用的功率模块。

RFMD 多市场产品部总裁 Bob Van Buskirk 指出: “我们正在生产以及正在开发的多个产品将从我们最新 GaN 技术的引用中获益。这种新的工艺技术为我们新成立的多市场产品组提供了直接的竞争优势, 我们 GaN 技术在多个终端市场中的不断部署将支持我们有关收入与利润随我们多市场产品组的持续发展而增长的预期。”

Van Buskirk 继续说道, “与当前可用的技术相比, RFMD 的新 GaN 工艺技术可提供更高效率、更大的运行带宽以及更高的强健性。这些性能特性正在支持多个高增长应用中的有利设计活动。”

技术概览

RFMD 的高效率、高功率 GaN 工艺技术在 48V 时展现出一流的 RF 性能，并且具有 5.6W/mm 平均 Psat、超高 60% 的平均峰值 PAE，以及在频率为 2.1GHz 时 24dB 的平均小信号增益。与当前可用的传统技术相比，RFMD GaN 技术的固有电气特性及出色可靠性提高了带宽、功率及效率。通过在多个晶圆批次上使用三温测试，计算的 180 摄氏度（工作结温）时的中值失效时间（MTTF）大于 1×10^6 小时。

关于 RFMD: RF Micro Devices (NASDAQ GS 代码: RFMD) 堪称设计与制造面向可推动无线与宽带通信的应用的高性能射频系统与解决方案的全球领先厂商。RFMD 的蜂窝前端、蜂窝收发器、RF 元件及片上系统 (SoC) 解决方案可实现全球移动性，提供更高的连接能力，以及支持蜂窝手机、蜂窝基站、无线局域网 (WLAN)、有线电视网络、航空、国防及全球定位系统 (GPS) 市场中的高级功能。RFMD 因其多样化的一流半导体技术以及广泛的 RF 系统专业技能而得到公认，并且是全球领先移动终端及 RF 设备制造商的首选供应商。

RFMD 总部位于北卡罗来纳、格林斯博罗，是一家在全球拥有工程、设计、销售及服务机构的 ISO 9001 及 ISO 14001 认证制造商。RFMD 在纳斯达克全球精选市场上市交易，交易代码为 RFMD。有关更多信息，请访问 RFMD 网站：www.rfmd.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含符合《1995 年美国私人证券诉讼改革法》“安全港”条例的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括，但不限于，有关我们计划、目标、陈述及论点的声明，并且并非历史事实，这些声明一般可通过诸如“可能”、“将”、“应该”、“能够”、“期望”、“计划”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”及类似措辞的使用加以辨别，尽管有些前瞻性声明是通过不同方式加以表述的。您应了解，本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断及期望，但我们的实际结果、活动和业绩可能与前瞻性声明所表达或暗示的有重大差异。除联邦证券法所要求的之外，我们不打算更新任何这些前瞻性声明，也不计划公开宣布对这些前瞻性声明的任何修订结果。RF Micro Devices 的业务受多种风险和不确定性因素的影响，包括季度运营结果的易变性；无线市场的成长与发展速率；与以下机构的运营相关的风险：我们的晶圆制造机构、分子束外延机构、我们的装配机构，以及我们的测试、带盘机构；吸引和保留熟练员工及培养领导者的能力；生产良率的易变性；采用新技术以降低成本、提高毛利率的能力；将新产品推向市场的能力；快速调整产能以适应产品需求变化的能力；对有限客户的依赖；对第三方的依赖。在由美国证券交易委员会归档的 RF Micro Devices 10-K 等报表的最新年度报告中更详细讨论的这些以及其它风险和不确定性因素，可能导致实际结果和发展与此处任何一个前瞻性声明中明示或暗示的意义存在本质性偏差。

RF MICRO DEVICES® 和 RFMD® 为 RFMD, LLC. 的商标。所有其它商品名称、商标及注册商标归其各自所有者所有。

###